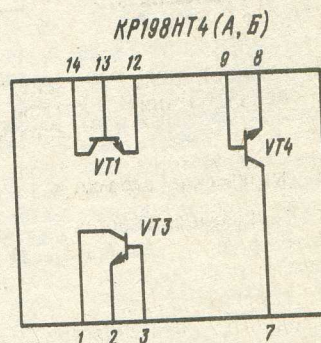
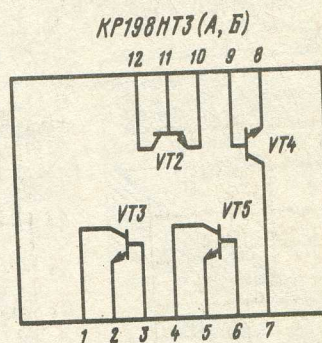
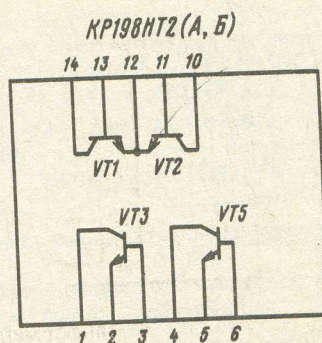
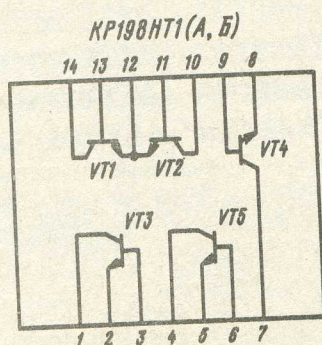
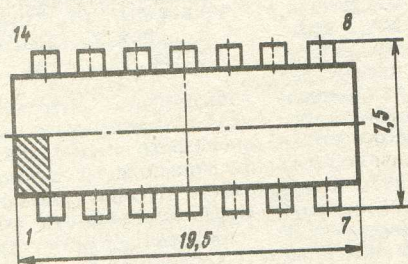
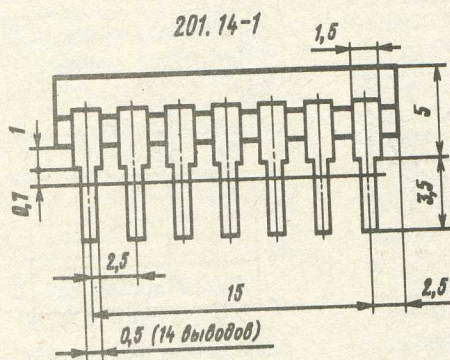


**KP198HT1A, KP198HT1Б,  
KP198HT2A, KP198HT2Б,  
KP198HT3A, KP198HT3Б,  
KP198HT4A, KP198HT4Б**

Микросхемы представляют собой матрицы *n-p-n* транзисторов. Различаются числом транзисторов, входящих в состав матрицы: KP198HT1 содержит пять транзисторов; KP198HT2, KP198HT3 — четыре; KP198HT4 — три.

Корпус типа 201.14-1 Масса не более 1,2 г.



**Электрические параметры**

Напряжение насыщения база—эмиттер при  $I_K=3$  мА,  $I_B=0,5$  мА,  $T=+25^\circ\text{C}$ , не более ..... 1 В  
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при  $I_K=3$  мА,  $I_B=0,5$  мА,  $T=+25^\circ\text{C}$ , не более ..... 0,7 В  
Обратный ток коллектора при  $U_{КБ}=6$  В,  $T=+25^\circ\text{C}$ , не более ..... 0,04 мкА  
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при  $U_{КЭ}=3$  В,  $I_3=0,5$  мА,  $T=+25^\circ\text{C}$ :

KP198HT1A, KP198HT1Б	KP198HT2A, KP198HT2Б	KP198HT3A, KP198HT3Б
KP198HT4A	KP198HT4Б	
20 ... 123	60 ... 250	